

製作氮化鎵基板及元件之方法

本院覽號

26A-990301

公告日期

智財權狀態

美國臨時案已申請、台灣(發明)I 451480放棄維護、美國US 8,501,597 B2放棄維護

摘要

此專利為製作大面積與低缺陷之三族氮化物半導體基板與其元件，此方法可以製作高品質低缺陷氮化鎵基板，並且與側向磊晶法(ELOG)相比較下此技術無存在高缺陷密度區域，此外此基板可以當作一獨立基板。

技術優勢

此發明提供一有效的技術可降低氮化鎵之缺陷密度，與側向成長法相比較，此方法為無任何一區域為高缺陷密度。

應用範圍

以氮化鎵基材之光電元件，例如 氮化鎵白光發光二極體，雷射二極體等

創作人

程育人、羅明華、郭浩中



中央研究院
ACADEMIA SINICA